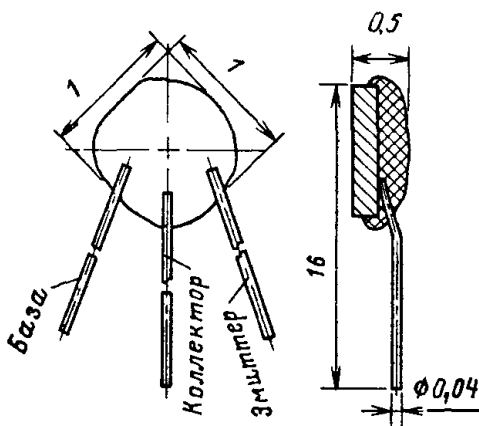


КТ211А-1, КТ211Б-1, КТ211В-1



Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные *p-n-p* с нормированным коэффициентом шума.

Предназначены для применения во входных каскадах, малошумящих усилителях, в герметизированной аппаратуре.

Бескорпусные, без кристаллодержателя, с защитным покрытием лаком, с гибкими выводами. Обозначение типа приводится на возвратной таре.

Масса транзистора не более 0,01 г.

Электрические параметры

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 5$ В, $I_{К} = 1$ мА не менее	10 МГц
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером при $U_{КБ} = 1$ В, $I_{Э} = 40$ мА:	
при $T = 298$ К:	
КТ211А-1	40–120
КТ211Б-1	80–240
КТ211В-1	160–480
при $T = 398$ К:	
КТ211А-1	40–200
КТ211Б-1	80–400
КТ211В-1	160–800
при $T = 213$ К:	
КТ211А-1	20–120
КТ211Б-1	40–240
КТ211В-1	80–480
Коэффициент шума при $U_{КБ} = 5$ В, $I_{Э} = 40$ мА, $f = 1$ кГц, $R_{Г} = 10$ кОм не более	3 дБ
Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 15$ В не более	10 мкА
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 5$ В, $f = 10$ МГц не более	20 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0,5$ В, $f = 10$ МГц не более	15 пФ

Материал взят из источника:

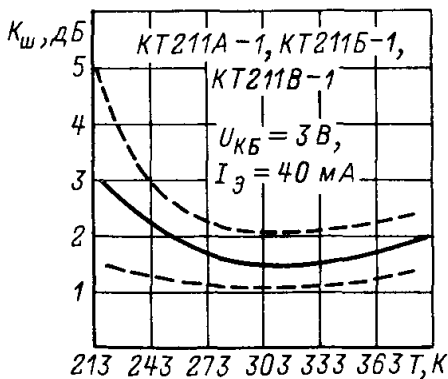
Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)
Энергоатомиздат, 1985

Предельные эксплуатационные данные

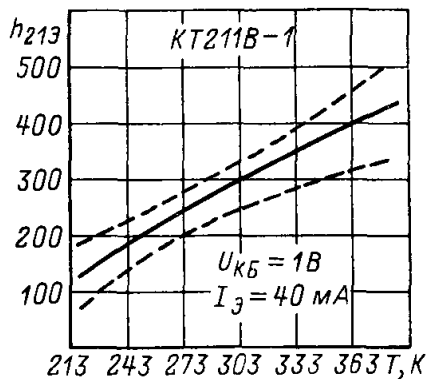
Постоянное напряжение коллектор-база	15 В
Постоянное напряжение эмиттер-база	5 В
Постоянный ток коллектора	20 мА
Импульсный ток коллектора при $\tau_{и} \leq 10$ мкс, $Q \geq$ ≥ 10	50 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:	
при $T = 213 \div 308$ К	25 мВт
при $T = 398$ К	5 мВт
Импульсная рассеиваемая мощность коллектора при $\tau_{и} \leq 10$ мкс, $Q \geq 10$	50 мВт
Температура перехода	423 К
Температура окружающей среды	От 213 до 398 К

Примечание При монтаже транзисторов в микросхему должны быть приняты меры, исключающие нагрев кристалла более 423 К. При монтаже транзисторов не допускается изгиб выводов на расстоянии менее 0,5 мм от места выхода из защитного покрытия

Пайка и сварка выводов допускается на расстоянии более 1 мм от места выхода вывода из защитного покрытия

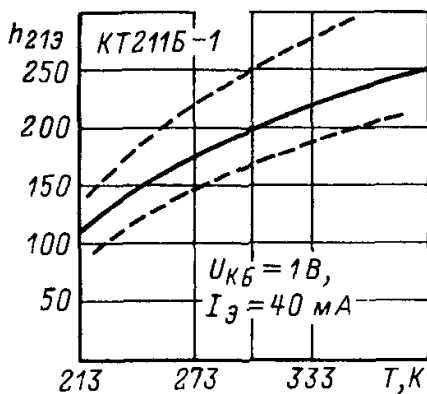


Зона возможных положений зависимости коэффициента шума от температуры.

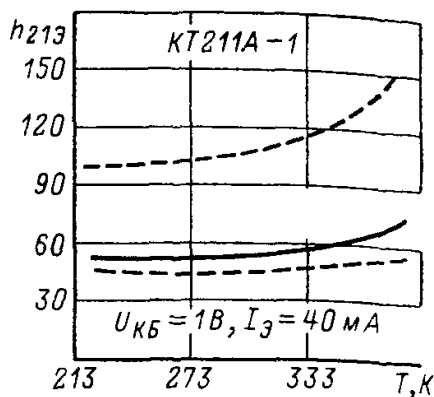


Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от температуры.

Материал взят из источника:



Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от температуры.



Зона возможных положений зависимости статического коэффициента передачи тока от температуры.

Материал взят из источника:

Полупроводниковые приборы: Транзисторы. Горюнов Н. Н. (ред)
Энергоатомиздат, 1985